

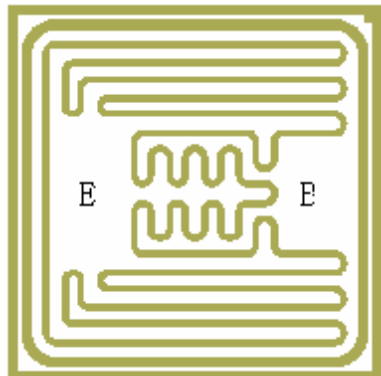
11003

硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

■用 途

主要用于节能灯、日光灯电子镇流器及其它开关、振荡电路。

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	1500μm×1500μm
压焊区尺寸	基 区 314μm×448μm 发射区 322μm×602μm
芯片厚度	240±10μm
锯片槽宽度	70μm
金属层	正面: Al 3.5±0.4μm 背面: Ag 1.4±0.2μm

■电特性(T_a=25℃)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最 小 值	最 大 值	典 型 值	单 位
集电极-基极截止电流	I _{CB0}	V _{CB} =350V		1		μA
发射极-基极截止电流	I _{EB0}	V _{EB} =9V		1		μA
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	I _C =0.1mA	350		400	V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =1mA	220		290	V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _E =0.1mA	9			V
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =5V, I _C =500mA	10	40		
集电极-发射极饱和电压	V _{CE(sat)}	I _C =500mA, I _B =100mA		0.5		V
基极-发射极饱和电压	V _{BE(sat)}	I _C =500mA, I _B =100mA		1		V
特征频率	f _T	V _{CE} =10V, I _C =200mA		5		MHz
贮存时间	t _S	I _C =500mA	1.5	4		μs